

描述

SS6200 是一款经过优化的单相 MOSFET 栅极驱动器，可驱动高侧和低侧功率 MOSFET 的栅极。

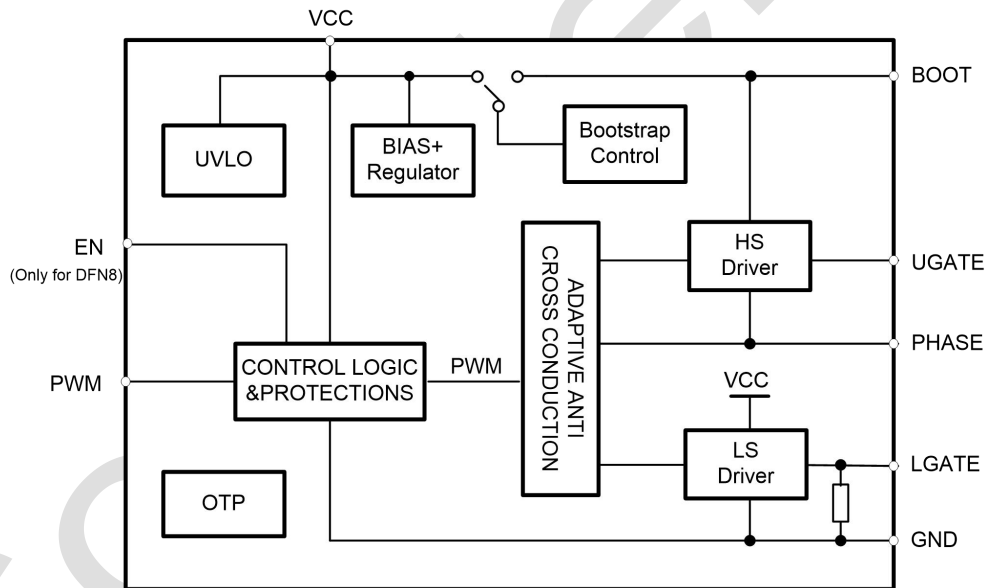
集成的自举二极管减少了外部元件数量。具有较宽的工作电压范围，可以优化高侧或低侧 MOSFET 栅极驱动电压以获得最佳效率。内部自适应无重叠电路通过防止两个 MOSFET 同时导通进一步降低开关损耗。

当 VCC 低于指定阈值电压时，UVLO 电路可防止故障发生。

应用程序

- 适用于 5W 至 20W 系统的无线充电器
- 半桥或全桥驱动 N+N MOSFET

框图

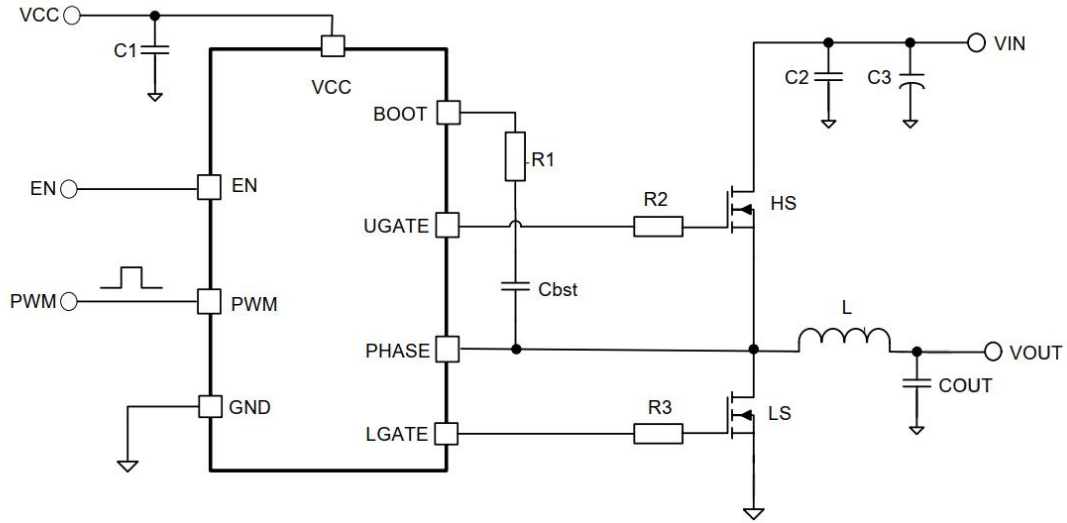


特性

- 驱动 2 个 N-MOSFETs
- 高频工作(高达 1MHz)
- 可以 3.3V 和 5V 的 PWM 输入
- 输出上升时间快
- 内部自举二极管
- 自适应穿透保护
- 欠压锁定
- 内部热关断
- 小尺寸封装: SOP8, DFN2x2-8L
- 这些都是 Pb-Free Devices

应用电路

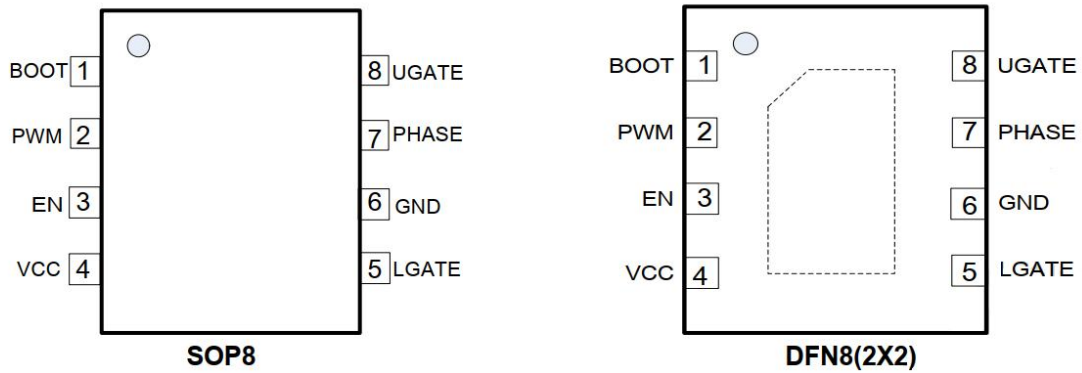
SOP8/DFN2x2-8L:



BOM 参考设计:

Name	Value	Name	Value
C1	10uF	R1	0
C2	0.1uF	R2	5ohm
C3	22uF	R3	0
Cbst	680nF		

引脚配置



引脚描述

引脚名称	描述	引脚序号
BOOT	上闸驱动的浮动引导供电引脚	1
PWM	输入 PWM 信号控制驱动器	2
EN	待机模式控制的逻辑输入	3
VCC	逻辑和低栅极驱动器电源电压	4
LGATE	下栅极驱动输出	5
GND	地	6
PHASE	将此引脚连接到高侧 MOSFET 的源极和 低侧 MOSFET 的漏极	7
UGATE	上栅极驱动输出	8